

반도체공학 정오표 [청문각]

면수	위치	수정 전	수정 후
130	위에서 8줄	(b)	(c)
130	밑에서 1줄	~으로 쓸 수 있다.	~으로 쓸 수 있다. 여기서 h' 는 $h/2\pi$ 이다.
131	식(4.3)	h'^2	h^2
133	밑에서 3줄	이 국간을	이 구간을
140	그림 4.15	(a)도체 (b) 절연체 (c) 반도체	(a) 도체 (b)반도체 (c) 절연체
160	그림 5.4	v_n	v_p
168	그림 5.12	불순물	산란
170	식(5.42) 위 2째줄	~실질적으로 다음의~	~실질적으로 $3\pi/8$ 의 보정 값을 고려하여 다음의~
176	연습문제5-13	$N_d=10^{21}$ $n=10^{21}$ $n=10^{21}$	$N_d=10^{22}$ $n=10^{22}$ $n=10^{22}$
188	식(5.95)	E_f	E_{fn}
189	식(5.96)	E_f	E_{fp}
189	식(5.97)	E_f	E_{fn}
189	식(5.98) 위의 줄	~ E_f 를 n형 페르미 준위 E_{fn} 으로 놓으면~	~그러므로 n형 페르미 준위 E_{fn} 은~
190	식(5.99)	E_f	E_{fp}
191	식(5.100),(5.101)	E_f	E_{fp}
191	식(5.102) 위의 줄	~ E_f 를 P형 페르미 준위 E_{fp} 로 놓고 구하면~	~p형 페르미 준위 E_{fp} 를 구하면~
195	11번 문제	이동도	도전률
195	“	()속에 오른쪽의 것 추가	$\mu_n=0.5[\text{cm}^2/\text{V.s}]$
195	12번 문제	()속에 오른쪽의 것 추가	$\mu_n=0.5[\text{cm}^2/\text{V.s}]$
195	13번 문제	힌트에서 $i = en\mu_p E$	$i = en\mu_n E$
196	19번 문제	힌트에서 오른쪽의 것으로 수정	$\rho = 1/e(n\mu_n + p\mu_p)$
196	20번 문제	힌트 추가	$v_d = \mu E = dx/dt \approx x/t$
204	연습문제6-3	(첫 문장에) 추가	“T=300[K]에서”
204	“	()속에 추가	~1.12[eV]이며, 단위는 []과 [eV] 중 어느 하나로 계산한다.)
221	식(6.61)	완쪽의 루트 속 2e 다음에 오른쪽의 것 추가	$\epsilon_o \epsilon_s$
243	식(7.5), 그 위 첫째 줄	t	d
288	식(7.63),(7.64)	$I_d \quad V_{gs}$	$I_D \quad V_{GS}$
189	식(7.66),식(7.67),(7.68)	$I_d \quad V_{gs} \quad R_s$	$I_D \quad V_{GS} \quad R_L$
290	식(7.69), (7.70)	$I_d \quad V_{gs}$	$I_D \quad V_{GS}$

표 1.1 <수정 표>

금속	텅스텐 (W)	알루미늄 (Al)	니켈 (Ni)	몰리브덴 (Mo)	백금 (Pt)	금 (Au)
일함수[eV]	4.55	4.28	5.15	4.60	5.65	5.10